

场效应管 MOS管 IRF7406 全新原装 IR F7406

产品名称	场效应管 MOS管 IRF7406 全新原装 IR F7406
公司名称	深圳市菱肯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:IR/国际整流器 型号:IRF7406 种类:绝缘栅(MOSFET)
公司地址	深圳市福田区华强北街道中航路鼎诚国际大厦1501
联系电话	18681598820

产品详情

场效应晶体管（field effect transistor缩写(fet)）简称场效应管。由多数载流子参与导电，也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高（ $10^8 \sim 10^9$ ）、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点，现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。

场效应管工作原理用一句话说，就是“漏极-源极间流经沟道的id，用以门极与沟道间的pn结形成的反偏的门极电压控制id”。更正确地说，id流经通路的宽度，即沟道截面积，它是由pn结反偏的变化，产生耗尽层扩展变化控制的缘故。在vgs=0的非饱和区域，表示的过渡层的扩展因为不很

大，根据漏极-源极间所加vds的电场，源极区域的某些电子被漏极拉去，即从漏极向源极有电流id流动。从门极向漏极扩展的过度层将沟道的一部分构成堵塞型，id饱和。将这种状态称为夹断。这意味着过渡层将沟道的一部分阻挡，并不是电流被切断。

在过渡层由于没有电子、空穴的自由移动，在理想状态下几乎具有绝缘特性，通常电流也难流动。但是此时漏极-源极间的电场，实际上是两个过渡层接触漏极与门极下部附近，由于漂移电场拉去的高速电子通过过渡层。因漂移电场的强度几乎不变产生id的饱和现象。其次，vgs向负的方向变化，让vgs=vgs(off)，此时过渡层大致成为覆盖全区域的状态。而且vds的电场大部分加到过渡层上，将电子拉向漂移方向的电场，只有靠近源极的很短部分，这更使电流不能流通。

金属-氧化层-半导体-场效晶体管，简称金氧半场效晶体管（metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, mosfet）是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管（field-effect transistor）。mosfet依照其“通道”的极性不同，可分为n-type与p-type的mosfet，通常又称为nmosfet与pmosfet，其他简称尚包括nmos fet、pmos fet、nmosfet、pmosfet等。

深圳市利捷世纪电子有限公司是一家专营电子元器件的现货分销商。主要经营美国整流器ir品牌系列、美国威世vishay品牌系列、美国仙童fairchild品牌系列、美国万代aosmd品牌系列、日本电气nec品牌、日本东芝toshiba、美国安森美on知名品牌系列厂家mos管、场效应管、二三极管、光电元器件、红外线发射接收器，产品广泛应用于商业、工业等领域。本公司产品在mos - fet (sop-8系列) 领域上占有全系列型号的现货库存和绝对的价格优势，为客户创造更高的竞争力和利润空间，各新老客户与本公司的合作将有不菲的收获和品质稳定！同时可根据客户的产品技术参数要求和需要提供全系列的配套服务。

公司本着“以质为根、以诚为本、以德为先、以信为生”的理念，在业内倡导市场共创、资源共享、共同发展的经营思想，长期备有大量现货，尽力满足客户在产品方面的需求，努力为广大终端产品生产商构筑一座直通、便捷、高效率、低成本的桥梁，已经与多家零售商和代理商建立了长期合作关系，在市场中赢得广大客户的信赖和支持。我们期待着与您共谋发展和建立长期的合作关系,根据市场的变化不断发展，创新，共同促进自己在各自产业领域上的壮大，共创辉煌。

专营、vishay(si)、ior(ir)、fairchild(fds,nds)、renesas(hat)、nec、aosmd(ao)、apex(ap)、anachip(af)、rohm、niko-sem等世界知名品牌系列贴片八脚系列mos管、场效应管、二三极管、光电元器件、红外线发射接收器、集成ic，型号齐全.欢迎询购.

联系方式：刘r

地址/add：深圳市福田区中航路都会100大厦银都24c

电话/tel：(86)0755- 6680 7521 / 8337 2921手机：13510110959

传真/fax：(86)0755-8397 0258

邮箱/e-mail：lijieic@163.com

msn：lijieic@live.com

qq：840102050 / 174420260

有需了解元器件详细参数、pdf请用阿里旺旺、qq、电子邮箱/e-mail联系

本产品的品牌是IR/国际整流器，型号是IRF7406，种类是绝缘栅(MOSFET)，沟道类型是资料，导电方式是增强型，封装外形是SMD(SO)/表面封装，材料是N-FET硅N沟道